⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) [□]

平2-96919

®Int. Cl. 5

ソ

識別記号

庁内整理番号

④公開 平成2年(1990)4月9日

G 11 B 5/66 5/704 7350-5D 7350-5D

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

國発明の名称 磁気記録媒体

②特 願 昭63-249284

@出 願 昭63(1988)10月3日

⑩発明者 山口 希世登 神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電機株式会

社内

⑩発明 者 大久保 恵司 神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電機株式会

社内

⑩発 明 者 山 崎 恒 神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号 富士電機株式会

社内

⑪出 顋 人 富士電機株式会社

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号

四代 理 人 弁理士 山口 路

明 細 響

1. 発明の名称 磁気配録媒体

2. 特許請求の範囲

1) ブラスチックまたはブラスチックとセラミックの複合材料からなる基板上に圧縮応力をもつ Si,N, 膜と引張応力をもつ Si,N, 膜とを交互に積み重ねたバッファ層、非磁性金属下地層、磁性層および保護網滑層をこの順に形成してなることを特徴とする磁気配録媒体。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は磁気記録装置に用いられる磁気ディスクなどの磁気記録媒体に関する。

〔従来の技術〕

第3図は従来用いられている磁気記録媒体の模式的な要部構成断面図を示したものである。第3図の磁気記録媒体はA&-Mg 合金基板1の上に非磁性金属基体層2を被優し、この非磁性金属基体層2上にさらに非磁性金属下地層3を介して例えばCo-Ni-Cr 合金導膜の磁性層4を被優し、磁

性層 4 上に保護調務層 5 を設けてあり、基板 1 に 非磁性金属基体層 2 から保護機滑層 5 までをこの 符号順に積み重ねたように構成したものである。

このように構成された磁気配録媒体は製造過程で基板1を所定の面相さ、平行度および平面を促せ上げ、非磁性金属基体層2はNiーP 合金を処理解めっきもしくは基板1自体をアルマイトのではあることにより形成するのが好ましく、いずれもでのできる必要とし、表面は機械的研磨を下でである。非政性金属引作のでは、引になるののでは、カードによりになるののでは、カードでは、10° などの保護調剤圏5を連続的にスパッタして被優する。

かくして得られた 田気配録 供体は 強度、 寸法精度などの 根核的 特性 および 田気 特性 も 良好 であり、例えば A.6-Mg 合金基板 1 上に 被優した Ni-P 基体 B 2 に Cr の非 西性 金属下 地 B 3 を 2000 Λ 、 Co-30 at 9 Ni-7.5 at 9 Cr 田性 B 4 を 500 Λ および カーボン 保護 潤 滑 B 5 を 500 Λ 連続 スパック

して形成したものの代表的な磁気特性として保証 カ Hc は 900 Oe でである。

以上のような磁気配録媒体は路特性の向上とと もに近年ますます軽量化とコストの低減に対する 要求が高められている。

〔発明が解決しようとする課題〕

配鉄鉄体の軽慢化とコスト低酸に対して考慮すべき点は基板材料の選択である。すなわち、A&-Mg 合金を基板に用いているために、この上に硬いNi-P Mを設けねばならず、基板面とNi-P Mの装価研磨加工に多大の時間を要し、このことがコストに大きな比率を占めている。したがって、この加工工数を短縮するためには、所定の面相さ、平行度および平面度に仕上げなければならないので、大幅な工数省略は不可能であってコストの低級には限界があり、A&-Mg 合金を用いる限り多くを期待するととができない。

一方基板材料の選択に関しては記録媒体の軽量 化も含めて、ブラスチックもしくはブラスチック とセラミックの複合材料を用いるのが有望である。

ることができる構造を有する磁気配像媒体を提供 することにある。

〔躁焰を解決するための手段〕

本発明の磁気記録媒体はプラスチックなどの非磁性基板上に、圧縮応力をもつ Si₁N₄ 凝と引張応力をもつ Si₂N₄ 凝とを交互に積み重ねたパッファ 層・非磁性金属下地層・磁性層および保護調慮を この順にスパッタ形成したものである。

(作用)

 これらの材料は A&-Mg 合金より 軽く、金型を用いて成形することができるので、金型の装面を高精度に加工しておくことにより、成形後の表面研磨を行なうことなく十分に良好な 面粗さや平行度が得られるという利点があるから である。

しかしながら、基板としてブラスチックまたは その複合材を用いるときは、別な問題が超きる、 それは、ブラスチックと金属の熱膨張係数にした。 を差があるためブラスチックあ板上に成膜にクラックが発生しやすい点である。 ラックは、その大きさおよびな量により、 蘇性低下や 田気配録に分って、 Ale-Mg 合 配 に の り プラスチックなどを基板に用いたときも配象 体の信頼性を損なわないようにする必要がある。

本発明は上述の点に選みてなされたものであり、 その目的は磁気配象媒体をより軽量とし、コスト を低減するためにプラスチックまたはプラスチッ クとセラミックの複合材料を用い、しかも良好な 磁気特性を有し、金属膜のクラック発生を防止す

るだけで応力を吸収または緩和する役割を果たす ことができない。

そこで本発明のようにパッファ層を同種の形態 の異なる膜を多層に積み重ねたものとして形成し、 応力伝播を避らせ、それぞれの膜の界面において 応力緩和を分担させることにより、全体の応力緩 和に寄与させることが可能となる。しかもこれら の膜は磁気配録媒体の製造工程上、成膜が容易で あることに加えて、成膜時の条件散定によって形 態の異なる同種の膜を交互に浸層できるものでな ければならない。 このようなことから、 パッファ 層としては圧縮応力をもつ SiaNa 膜と引張応力を もつ SiaNa 膜との組み合わせは両者の密滑性、略 合性の点からも好通であり、これらを交互に積層 すると、パッファ層全体として所定の厚さの中に 形限の異なる同種の膜が一つ資きに積み重ねられ たものとなり、このパッファ層がプラスチック共 板と金属膜との熱膨張係数の大きな差によって生 ずる内部応力を緩和し、金属膜のクラック発生を 防止するように作用する。

〔寒 施 例〕

以下本発明を実施例に基づき説明する。

第1図は本発明により得られた磁気記録媒体の 模式的な要部構成断面図を示したものであり、 第 3図と共通部分を同一符号で扱わしてある。 第1 図は第3図と基本的な構成は同じであるが、 第1 図が第3図と異なる点は基板1a にブラスチック を用い、 基板1a と非磁性金属下地層3との間に、 非磁性金属基体層2ではなく、 バッファ 層 6 が介 在するように構成したことにある。

この 田気記録媒体はまず 基板材料にポリェーテルイミド 樹脂の 商品名 クルテム 1000 を用い、所定の 表面 特度をもった 金型により成形して 基板 1a を作製し、この 基板 1a 上に 圧縮 応力をもつ Si_1N_4 膜($2\sim5\times10^6$ dyn/d) 6a と 引張 応力をもつ Si_1N_4 膜($-1\sim-4\times10^9$ dyn/d) 6b を 交互に 積層して なる パッファ 層 6 を 形成するが、 第1 図では 便宜上 これら 薄膜の 積層 数を 6 層とした 場合で示してあり、 圧縮 応力をもつ Si_1N_4 膜 6a と引張 応力をもつ Si_1N_4 膜 6a と 引張 応力をもつ Si_1N_4 膜 6a と 引張 応力をもっ Si_1N_4 膜 6a と の 8a に a に

このとき圧縮応力をもつ SiaNa 膜 6 a と 引張応力をもつ SiaNa 膜 6 b を形成するための成膜圧力を変える回数、すなわちこれらの膜が交互に殺み重ねられる機関数については、その効果を確かめるために、各成限圧力条件10回の繰り返しによる10 層までの積満数を有する独々のパッファ層 6 を形成した。また比較のために、1 mTorr 以下での成既圧力、それぞれ単独で行なった圧縮応力をもつ SiaNa 膜 6 a のみと、引張応力をもつ SiaNa 膜 6 a のみと、引張応力をもつ SiaNa 膜 6 b のみのパッファ 圏を作製し、一方ポリエステル樹脂と炭酸カルシウムとの複合材料からなる基板も作製した。

さらにパッファ層 6上に順次形成する非磁性金属下地層 3 の Cr , 磁性層 4 の Co - Ni - Cr 合金および保護網滑層 5 のカーボンの成蹊をいずれもDCスパッタ法により次の条件により行なう。

基板温度:80℃以下

原 料: Crターゲット、Co-Ni-Cr合金ター ゲット、Cターゲット、Arガス

成膜圧力: 10 m Torr

ことで圧縮応力をもつ Si₂N₄ 膜 6 a と引張応力をもつ Si₂N₄ 膜 6 b は次のようにして形成される。すなわち、同一反応槽内で E C R ブラズマ C V D と D C スパッタとが可能な装置により、 E C R ブラズマ C V D 法を用いて、基板温度 80 で以下とし、原料の Si H₄ , N₂ ガスを導入して成膜圧力は 0.5~5 mTor・の範囲で変化させる。このとき成膜圧力が 1 mTorr 以下で圧縮応力をもつ Si₂N₄ 膜 6 a が形成され、成膜圧力を1 mTorr以上にすると引張応力をもった Si₂N₄ 膜 6 b を形成することができる。この成膜圧力の変化を繰り返し行ない、膜6 a と膜 6 b がそれぞれ 50 Åの厚 さとなるように交互に成膜機層することによりパッファ 層 6 が得られる。

次に以上のごとくして得られたそれぞれの磁気 記録媒体について金属膜に発生するクラック数と 耐食性能について比較を行ない、その結果を餌2 図(a),(b)に示す。第2図(a)は縦軸を非磁性金融下 地層 3 の Cr に発生する単位面段(1111)あたりの 1 #m以上のクラック数とし、横軸をパッファ層 6 内に交互に積み重ねるように成膜した圧縮応力を もつ Sia Ne 膜 6 a と引張応力をもつ Sia Ne 膜 6 b との積層数とし、それぞれの磁気記録媒体につい て10点御定した平均値をブロットしたものである。 第2図(b)は、縦軸を媒体の代表的な磁気特性であ る残留磁束密度Brと、磁性層4の膜厚8の積値 Br・8 について、80℃, 80 % R H 環境内に放戦し た1ヶ月耐食性試験後の彼少率ムBr・8とし、機 軸は第2図(a)と同様膜 6 a と膜 6 b の積層数を表 わし、ブロットは同じく10点行なって平均値を用 いた。

第2図(a), (b)ともに、本発明によるパッファ lb 6を形成するのにブラスチック基板を用いたもの (o), 同じくブラスチック複合材の基板を用いた もの (①) , 比較のためのプラスチック基板を用いた圧縮応力をもつ Si , N , 膜 6 a 単独のもの (本) および引張応力をもつ Si , N , 膜 6 b 単独のもの (×)を併記してある。

第2図(a),(b)の両図を参照すればわかるように、パッファ暦 6 が単一材料の一層のみでは膜 6 a, 膜 6 b のいずれの場合も、 Cr 下地層 3 に80 個以上のクラックが発生し、それが原因となって ΔBr・δ 値は 5 %以上に達する。 このことは単一材料の場合この実施例の範囲で 膜厚を変化させても同じである。 ΔBr・δ 値が 5 %以上になると 医気配録 媒体の配鉄, 再生の繰り返しによるエラーが増加するので、パッファ 層 6 としては単一材料のみで形成するのが 逐当でないことは 明らかである。

基板1aと非低性金属下地層3のCr との大きな 熱膨張係数の相違に起因して生ずる内部応力を膜 6aと膜6bがそれぞれの外面で吸収または緩和 するように働き、その結果金属下地層3のCr に クラックが発生するのを防止することができる。

また本発明の磁気記録媒体を磁気記録装置に組み込んでCSS試験を行なった結果、2万回のコンタクト・スタート・ストップに対しても、この 媒体装画にはなんら毎の発生は見られず、再生出 力もほとんど低下することなく、十分な耐久性を もっていることを確認することができた。

そのほか本発明の磁気記録媒体は基板にブラステックまたはその複合材料を用いているために、 従来の All - Mg 合金基板より約60 %軽量になると ともに、複雑な研磨工程を必要とせず、基板上に 堆板させる各層は本発明に係るパッファ層も含め で同一反応槽内で順次形成させればよいという利 点もある。

〔発明の効果〕

衄気記録解体は軽量にするとともに、コストの

第3図に示した従来の A.8 合金基板 1 に Ni ー P めっきの非磁性金属下地層 2 を被覆した磁気配録 供体における ABr・8 値 1.5 % ~ 2 % とほぼ 同等の値が得られる。また同時に作製したポリエステル樹脂と炭酸カルシウムとの複合材料を基板とする磁気配録 媒体も、ポリエーテルイミド樹脂の基板を用いたものと同様の効果があることを第2図(a),(b)から確認することができる。

圧縮に力をもつ SiaNa 膜 6 a や引張応力をもつ SiaNa 膜 6 b を単独にバッファ暦 6 として用いるときは、その膜厚は 1000 Å以上を必要とすると 考えられるが、本発明では圧縮応力をもつ SiaNa 膜 6 a と整合性のよい引張応力をもつ SiaNa 膜 6 b との積層体としてバッファ 6 6 を形成したために、膜 6 a と膜 6 b の厚さがいずれも50 Åであるから、10 層重ねたとしても、バッファ層 6 の膜厚は 500 Åで足りることになる。

以上のように圧縮応力をもつ SiaNa 膜 6 a と引 張応力をもつ SiaNa 膜 6 b を交互に 横層形成した パッファ層 6 を有する本発明の無気配鉄媒体は、

低減が望まれており、加工工数の多い従来のAB 合金蓄板に代って、後加工なしで高い最面特限の 得られるプラスチックまたはその複合材料を用い ることができるが、これらブラスチック系材料の 基板は、その上に形成される金属膜(Cr)と熱能 張係数が大きく異なるため、成膜後の金属膜にク **ラックを発生し、このことが原因となって媒体の** 耐食性能が著しく低下する。これに対して本発明 の磁気記録媒体は実施例で述べたように、ブラス チック系基板と金属膜との間に、成膜圧力を変化 させることにより形成される圧縮応力をもつSi, Na 膜と引張応力をもつ Si₃N₄ 膜とを交互に積み重ね たパッファ層を介在させるようにしたため、必板 と金属膜の私膨張係数の差により生ずる内部応力 を、積層されたそれぞれの膜の界面で吸収または 緩和するように分担することが可能となり、これ が単一材料のパッファ層では不可能であった500 。 A.以下の膜厚のパッファ層で応力緩和を実現させ、 その結果金属膜にクラックが発生するのを防ぐこ とができる。

以上のことから、本発明の磁気配録媒体はアルミニウム系基板を用いたときに起きる本質的な欠点を排除し、従来の A.O 合金基板を用いた媒体と同様の耐食性能および信頼性を維持するものである。

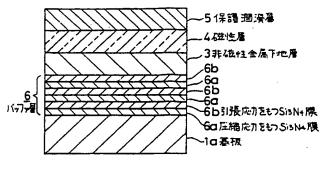
4.図面の簡単な説明

第1 図は本発明の磁気記録媒体の要部構成を示す模式断面図、第2 図回は本発明の磁気記録媒体ののでは、1 2 図回は本発明の磁気記録媒体のでは、1 3 図はで来の磁気記録媒体の要形構成を示す模式断面図である。

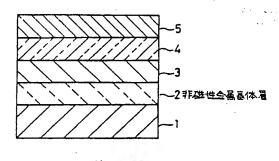
1,1a ··· 基板、2 ··· 非田性金属基体層、3 ··· 非田性金属下地層、4 ··· 田性膚、5 ··· 保護陶滑層、6 ··· パッファ層、6 a ··· 圧縮応力をもつ Sia Na 膜、6 b ··· 引張応力をもつ Sia Na 膜。

代理人并理士 山 口

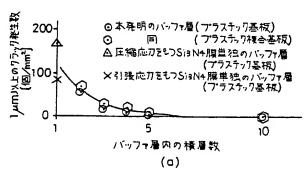


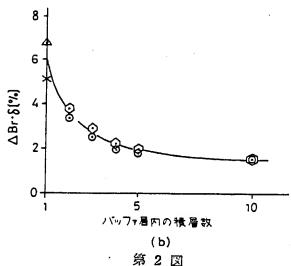


第1図



第 3 図





-117-